

# الترانزستور Transistors

## الترانزستور:

عندما تضاف طبقة ثالثة للثنائي بحيث يكون وصلتين فان الناتج هو عنصر جديد يطلق عليه " الترانزستور "

ويتمتع الترانزستور بقدرة عالية على تكبير الاشارات الالكترونية ، هذا بالرغم من حجمة الصغير

## أنواع الترانزستور:

هناك نوعين من الترانزستور يختلف كل واحد في تركيبه وهما كالتالي:

### 1- الترانزستور ال PNP :

يحتوى الترانزستور ال PNP على ثلاثة بللورات اثنتان موجبتان P وبينهما واحدة



سالبة N ليتكون بذلك الترانزستور ال PNP

### 2- الترانزستور ال NPN :

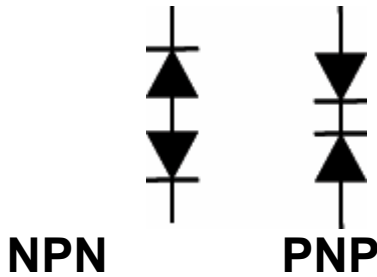
يحتوى الترانزستور ال NPN على ثلاثة بللورات اثنتان سالبتان N وبينهما واحدة



موجبة P ليتكون بذلك الترانزستور ال NPN

تركيب الترانزستور :

يحتوى الترانزستور على وصلتين وبذلك يمكن اعتباره كثنائين موصل بين ظهرا لظهر او وجهها لوجه وذلك كما في الشكل



يحتوى كل ترانزستور على ثلاث اطراف وهي كما يلي :

**1- المشع Emitter :** وهو الجزء المختص بامداد حاملات الشحنة ( الفجوات في حالة الترانزستور PNP والالكترونات في الترانزستور NPN ويوصل المشع أماميا (forward) بالنسبة للقاعدة وبذلك فهو يعطي كمية كبيرة من حاملات الشحنة عند توصيلة .

**2- المجمع Collector :** ويختص هذا الجزء من الترانزستور بتجميع حاملات الشحنة القادمة من المشع ، ويوصل عكسيا (reverse) مع القاعدة .

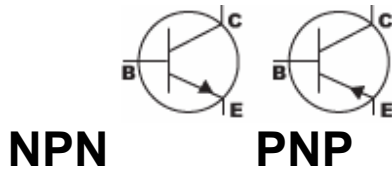
**3- القاعدة Base :** وهي عبارة عن الجزء الأوسط بين المشع والمجمع ويوصل أماميا (forward) مع المشع ، وعكسيا (reverse) مع المجمع  
رموز الترانزستور :

هناك رمزين للترانزستور والسهم يدل على نوعه كما بالشكل:

يدل السهم على نوع الترانزستور

1- السهم الخارج يدل على ترانزستور NPN

2- السهم الداخل يدل على ترانزستور PNP



NPN

PNP

### أشكال الترانزستور:



ترانزستور معدني



ترانزستور عادي

### خصائص الترانزستور:

يوصل الترانزستور تيارا في الاتجاه الأمامي ولا يوصل تيارا في الاتجاه العكسي ومنطقة التوصيل تنقسم الى ثلاث مناطق :

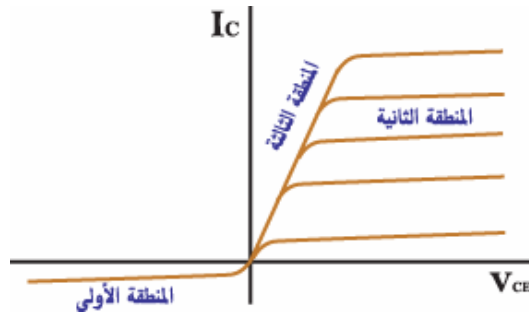
المنطقة الأولى: وهي منطقة القطع التي لا يمر فيها تيار في مجمع Base الترانزستور

المنطقة الثانية: وهي منطقة التكبير أو المنطقة الفعالة أو منطقة التشغيل الخطية للترانزستور .

المنطقة الثالثة: وهي منطقة التشبع التي يمر فيها أكبر تيار في مجمع Base

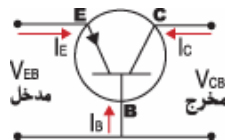
الترانزستور

في المنطقة الأولى والثالثة يعمل الترانزستور كمفتاح ، وفي المنطقة الثانية يعمل الترانزستور كمكبر



### طرق توصيل الترانزستور:

يوصل أحد أطراف الترانزستور بإشارة الدخل والطرف الثاني يوصل بإشارة الخرج ويشترك الطرف الثالث بين الدخل والخرج ، ولهذا يوصل الترانزستور في الدوائر الالكترونية بثلاث طرق مختلفة



# طرق توصيل الترانزستور Transistor Connection Types

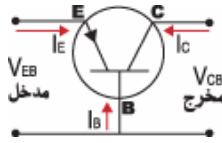
## طرق توصيل الترانزستور :

يوصل أحد أطراف الترانزستور بإشارة الدخل والطرف الثاني يوصل بإشارة الخرج ويشترك الطرف الثالث بين الدخل والخرج ، ولهذا يوصل الترانزستور في الدوائر الالكترونية بثلاث طرق مختلفة .

### القاعدة المشتركة Common Base :

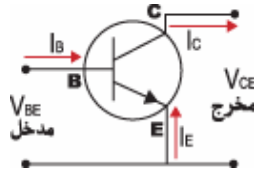
توصيل إشارة الدخل بين المشع والقاعدة Emitter and Base ، وتوصل إشارة الخرج بين المجمع والقاعدة Base Collector and القاعدة Base مشتركا بين الدخل والخرج ، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالقاعدة المشتركة

### Common Base



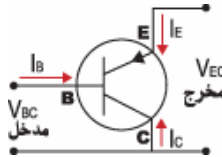
### المشع المشترك Emitter Common :

توصل إشارة الدخل بين القاعدة والمشع Emitter and Base ، وتوصل إشارة الخرج بين المجمع والمشع Base and Emitter ويلاحظ أن طرف المشع Emitter مشترك بين الدخل والخرج ، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالمشع المشترك Common Emitter.



### المجمع المشترك Common Collector :

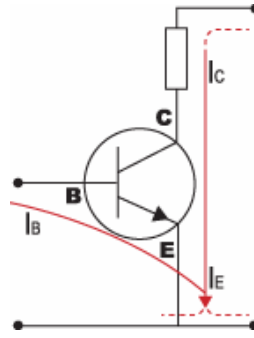
توصل إشارة الدخل بين القاعدة والمجمع Collector and Base ، وتوصل إشارة الخرج بين المشع والمجمع Base and Emitter and Collector مشترك بين الدخل والخرج ، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالمجمع المشترك Collector Common.



## بعض الحقائق عن الترانزستور :

1- طبقة القاعدة Base في الترانزستور تكون رقيقة جدا يليها المشع Emitter أكبرهم المجمع Collector.

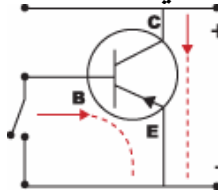
- 2- يكون المشع Emitter مشعباً بحاملات الشحنة بحيث يمكنه امداد عدداً هائلاً منها أما القاعدة Base فتكون خفيفة التشعب وتعمل على امرار غالبية الشحنات القادمة من المشع Emitter الى المجمع Collector ويكون المجمع متوسط التشعب.
- 3- وصلة المشع مع القاعدة Emitter-Base تكون أمامية Forward دائماً أما وصلة المجمع مع القاعدة Collector-Base فتكون عكسية Reverse.
- 4- يتميز المشع Emitter عن بقية أطراف الترانزستور بوجود سهم عليه ، يشير السهم الى اتجاه التيار ( الفجوات ) ، ففي نوع PNP نجد أن التيار ( الفجوات ) يتدفق خارجاً من المشع Emitter أما في النوع NPN نجد أن التيار يتجه داخلاً الى المشع Emitter.



### هناك مساران للتيار في دوائر الترانزستور:

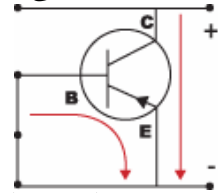
#### المسار الأول: المجمع Collector – المشع Emitter.

فإذا سلط فرق جهد بين مجمع Collector ومشع Emitter ترانزستور من النوع PNP بحيث يكون المجمع Collector موجبا بالنسبة للمشع Emitter وتركت دائرة القاعدة Base – المشع Emitter مفتوحة فسوف لا يمر تيار لا في دائرة المجمع Collector – المشع Emitter ولا في دائرة القاعدة Base – المشع Emitter .



#### المسار الثاني: القاعدة Base – المشع Emitter.

إذا سلط جهد انحياز أمامي على دائرة القاعدة Base – المشع Emitter قيمته (0,7) فولت فإن عدد من الالكترونات تترك المشع Emitter بسبب جهد الانحياز الأمامي بين القاعدة Base والمشع Emitter متجهة نحو القاعدة Base .  
وحيث أن القاعدة Base غير مشعبة بالشحنات ورقيقة جداً (1 1000 من المللي متر) ، لذلك فإن عدد الالكترونات التي تتحد بالفجوات في القاعدة Base يكون قليلاً جداً لا يتعدى 1 % من الالكترونات المشع Emitter التي تتجه نحو القاعدة Base



يقوم الجهد الموجب للمجمع Collector بجذب هذه الالكترونات نحوه لتكون  $r$  التيار المار في دائرة المجمع Collector – المشع Emitter.

مما سبق نستنتج أن

- 1- يكون الترانزستور في حالة قطع اذا كان جهد القاعدة – المشع أقل من 0.7 فولت في حالة ترانزستورات السيليكون ، 0.3 فولت في حالة ترانزستورات الجرمانيوم.
- 2- في الوقت الذي يكون فيه جهد القاعدة – المشع يساوى من 0.7 فولت في ترانزستورات السيليكون يتزايد تيار المجمع بتزايد تيار القاعدة
- 3- تيار القاعدة أصغر بكثير من تيار المجمع ولكنه يتحكم فيه ، أى أن النقص القليل في تيار القاعدة يناظره نقص كبير في تيار المجمع والزيادة القليلة في تيار القاعدة يناظرها زيادة كبيرة في تيار المجمع.
- 4- ولهذا تدخل الإشارة صغيرة الى دائرة القاعدة – المشع وتخرج كبيرة من دائرة المجمع – المشع.

الترانزستور (بالإنجليزية Transistor: وهي اختصار لكلمتي Transfer Resistor وتعني مقاومة النقل) أحد أهم مكونات الأدوات الإلكترونية الحديثة مثل الحاسوب، اخترعه العلماء الأمريكيون (والتر براتن) و(جون باردين) و(وليام شكولي). هو بلورة من مادة شبه موصل مطعمة كالجرمانيوم أو السيليكون تحتوي على بلورة رقيقة جداول حيث تكون المنطقة الوسطى منها شبه موصل موجب أو سالب وتسمى القاعدة بينما المنطقتان الخارجيتان من النوعية المخالفة وله قدرة كبيرة على تكبير الاشارات الالكترونية.

يمكن استخدام الترانزستور كمفتاح أو كمكبر للجهد أو التيار أو كلاهما.

والترانزيستور عبارة عن مفتاح كهربائي متناهي الدقة، يشبه مفتاح الضوء التقليدي الذي يحتوي على وضعين (تشغيل وتوقيف). (ويتضمن الترانزيستور 3 محطات طرفية هي: المصدر والمخرج والمجفف. وحين يوضع فولت موجب صغير في المخرج، يقوم الأخير بجلب الإلكترونات التي تحمل الشحنة السالبة، وبالتالي يولد التيار الكهربائي الذي يتدفق بين المصدر والمجفف، وفي هذه الحالة يكون الترانزيستور في وضع التشغيل. وعند وجود شحنة سالبة في المخرج، يتوقف تدفق التيار بسبب تكاثر عدد الإلكترونات وبالتالي يتوقف الترانزيستور.

وتعتمد سرعة الترانزيستور في الانتقال من حالة التشغيل إلى التوقيف المعروفة باسم "القتاة" على طول المسافة التي يجب على الإليكترونات أن تعبرها بين المصدر والمخرج والمجفف. وسمحت هذه الوظيفة الثنائية للكمبيوتر بمعالجة المعلومات؛ حيث أصبح يشار إلى مرحلة تشغيل الترانزيستور بالرقم(1)، بينما يشار إلى مرحلة التوقيف بالرقم(0)، وعندها لا يتدفق التيار الكهربائي بين المحطات الطرفية للترانزيستور.

لقد تم الحصول على الترانزيستور عام (1948-1949) نتيجة للدراسات التي قام بها العالمان باردين وبراتين وذلك في مخبر ( تلفون بل ) الأميركية لاستخدامه بدلاً من الصمامات الإلكترونية التي كانت شائعة في تلك الأيام.

وتتألف كلمة الترانزيستور من كلمتين **transfer** وتعني تحويل ( أو نقل) وكلمة **resistor** وتعني مقاومة وذلك بعد حذف الأحرف الأخيرة **fer** من الكلمة الأولى والأحرف الأولى **res** من الكلمة الثانية.

وإننا لنشك فيما إذا كان من الممكن أن تصل صناعة أجهزة الجسم الصلب إلى ما وصلت إليه اليوم لو لم يكن الترانزيستور (الذي يعد امتداداً للتثاني) هو الباحث على البحث والتطوير الذي أصاب المواد نصف الناقلية وعمليات صنع الأجهزة حيث يشغل الترانزيستور المقام الأول في الإلكترونيات المعاصرة ويرجع ذلك بشك كبير إلى كونه جهاز تضخيم ممتاز صغير الحجم يمكن أن يعول عليه بالإضافة إلى القدرة الصغيرة التي يتطلبها.

والترانزيستور كجهاز تضخيم يحول الإشارة الضعيفة التابعة للزمن إلى إشارة قوية. وهناك وظائف مهمة أخرى يستطيع الترانزيستور أن يقوم بها في الدارات الإلكترونية لكن مقدرته على التضخيم تعد الوظيفة الرئيسية بالنسبة لاستخداماته الأخرى.

يمكن أن نميز صنفين من الترانزيستورات:

1- ترانزيستور ثنائي القطبية. **bipolar**.

2- ترانزيستور وحيد القطبية. **unipolar**.

حيث اعتمد في هذا التصنيف على آلية مرور التيار ففي الترانزيستور ثنائي القطبية يعتمد مرور التيار على نوعي حاملات الشحنة (إلكترونات وثقوب) أما الترانزيستور وحيد القطبية فإن مرور التيار يعتمد على نوع واحد من حاملات الشحنة (إلكترونات أو ثقوب).

وبكلام آخر فإن النوع الأول (ثنائي القطبية) يعمل بفعل حاملات الشحنة من النوعين الأكثرية والأقلية معاً أما النوع الثاني فإنه يعمل بفعل حاملات الشحنة الأكثرية فقط.

يمكن أن تصنف الترانزيستورات أيضاً من حيث آلية العمل فالصنف الأول (والذي يوافق الترانزيستورات ثنائية القطبية) تسمى بالترانزيستورات الوصلية حيث يتم التحكم في التيارات الداخلية بواسطة متصلين ثنائيين pn أما النوع الآخر فتسمى بالترانزيستورات الحقلية حيث يستند في أساس عمله على أثر الحقل.

للترانزيستورات بشكل عام ثلاث أطراف تأخذ الأسماء التالية:

1- من أجل الترانزيستورات ثنائية القطبية :

1- الباعث (emitter)

2- القاعدة (base)

3- المجمع (collector)

2- من أجل الترانزيستورات أحادية القطبية:

1- المنبع (source)

2- المصرف (drain)

3- البوابة (gate)

على الرغم من المردود الكبير للترانزيستور وماله من محاسن وميزات إيجابية (مقارنة مع الصمامات) إلا أن هناك سلبية أساسية وهي كونه حساس جداً لارتفاع درجة الحرارة ذلك أن مكوناته قابلة للعطب في حال ارتفاع درجة الحرارة إلى حدود معينة فعلى سبيل المثال درجة الحرارة الأعظمية المسموح بها لترانزيستور جرمانيوم تقع بين (60-100) درجة مئوية ولترانزيستور سليكون بين (125-200) مئوية. وهذا أحد أسباب تفضيل استخدام السيليكون في تصنيع الترانزيستور.

وللتغلب على هذا العائق تم إضافة المبردات للترانزيستور (وهي عبارة عن قطع معدنية ذات مواصفات معينة توصل مع الجسم الخارجي للترانزيستور) تعمل هذه المبردات على امتصاص الحرارة الزائدة الناتجة عن عمل الترانزيستور والتي يمكن أن تخرب البنية الداخلية) أنصاف النواقل) للترانزيستور.

أهمية الترانزيستور:

يعتبر الترانزيستور من أهم القطع الإلكترونية حيث أنه يدخل في تركيب معظم الدوائر المتقدمة. وقد تم تطويره لأول مره في معامل بل سنة 1948م .

تتألف كلمة الترانزيستور من كلمتين transfer وتعني تحويل أو نقل وكلمة resistor وتعني مقاومة وذلك بعد حذف الأحرف الأخيرة fer من الكلمة الأولى والأحرف res من الكلمة الثانية .

والترانزيستور عبارة عن مفتاح كهربائي متناهي الدقة، يشبه مفتاح الضوء التقليدي الذي يحتوي على وضعين (تشغيل وتوقيف. )

## الوصلة الثلاثية ( الترانزستور )

عبارة عن وصلة ثلاثية من بلورة الجرمانيوم أو السليكون تحتوي على :  
1-بلورة ( وصلة ) رقيقة جداً من النوع الموجب أو السالب تسمى القاعدة وتوجد في الوسط.

2-يحيط بالقاعدة بلورتان ( وصلتان ) من نوع مخالف للقاعدة وأكبر في المساحة منها وهما :-  
الباعث وعليه سهم يشير إلى اتجاه سريان التيار فيه] ب[ الجامع

كيف يعمل الترانزيستور؟

تعمل القاعدة في الترانزستور كمفتاح لتشغيل أو إطفاء الترانزستور فعندما يسري التيار إلى القاعدة سيكون هناك طريق لسريان التيار من المجمع إلى الباعث (فيكون المفتاح بوضع التشغيل). ولكن إذا لم يسري تيار إلى القاعدة فإن التيار لن يمكنه السريان من القاعدة إلى الباعث) فيكون المفتاح بوضع الإطفاء)

استخدامات الترانزيستور:

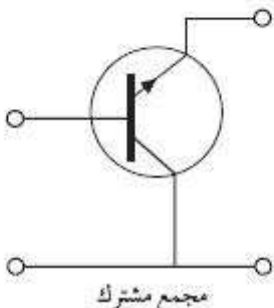
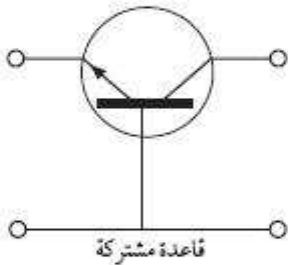
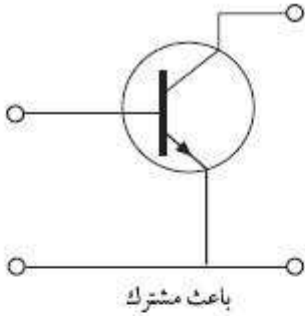
تضخيم الجهد أو التيار أو القدرة وذلك حسب توصيلة في الدوائر كالتالي:

1-دائرة القاعدة المشتركة تستخدم لتضخيم فرق الجهد.

2-دائرة المجمع المشترك تستخدم لتضخيم شدة التيار.

3-دائرة الباعث المشترك تستخدم لتضخيم القدرة

الكهربائية.



طرق توصيل الترانزستور ( للإطلاع: )





يوصل أحد أطراف الترانزستور بإشارة الدخل والطرف الثاني يوصل بإشارة الخرج ويشترك الطرف الثالث بين الدخل والخرج ، ولهذا يوصل الترانزستور في الدوائر الالكترونية بثلاث طرق مختلفة.

**القاعدة المشتركة: Common Base**

توصيل إشارة الدخل بين المشع والقاعدة **Emitter and Base** ، وتوصل إشارة الخرج بين المجمع والقاعدة **Collector and Base** ويلاحظ أن طرف القاعدة **Base** مشتركا بين الدخل والخرج ، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالقاعدة المشتركة. **Common Base**

**المشع المشترك: Common Emitter**

توصل إشارة الدخل بين القاعدة والمشع **Emitter and Base** ، وتوصل إشارة الخرج بين المجمع والمشع **Base and Emitter** ويلاحظ أن طرف المشع **Emitter** مشتركا بين الدخل والخرج ، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالمشع المشترك. **Common Emitter**

**المجمع المشترك: Common Collector**

توصل إشارة الدخل بين القاعدة والمجمع **Collector and Base** ، وتوصل إشارة الخرج بين المشع والمجمع **Base and Emitter** ويلاحظ أن طرف المجمع **Collector** مشتركا بين الدخل والخرج ، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالمجمع المشترك. **Common Collector**

معامل التضخيم : هو نسبة الجهد الناتج إلى الجهد الداخل.  
وبما أن شدة التيار الداخلة والخارجة تقريبا متساوية ( ت المجمع = ت الباعث ) . إذا:

معامل التضخيم = (م) المجمع / (م) الباعث

ملاحظات:

- 1- تيار الباعث = تيار المجمع
- 2- معامل التضخيم أكبر من الواحد الصحيح لأن م للمجمع أكبر بكثير من م للباعث

### كيفية عمل الترانزستور

**أولا :** توصل القاعدة والباعث بجهد ثابت توصيلا أماميا ( جهد الانحياز الأمامي ) وبالتالي يكون حاجز الجهد بين المنطقتين صغيرا جدا وعلى ذلك تكون مقاومة وصلة الباعث - القاعدة صغيرة

**ثانيا :** يوصل المجمع والقاعدة بجهد ثابت توصيلا خلفيا ( جهد الانحياز العكسي )

وبالتالي تكون مقاومة وصلة المجمع - القاعدة عالية

نلاحظ أن القاعدة تكون موجبة بالنسبة للباعث ويكون المجمع موجبا بالنسبة للقاعدة

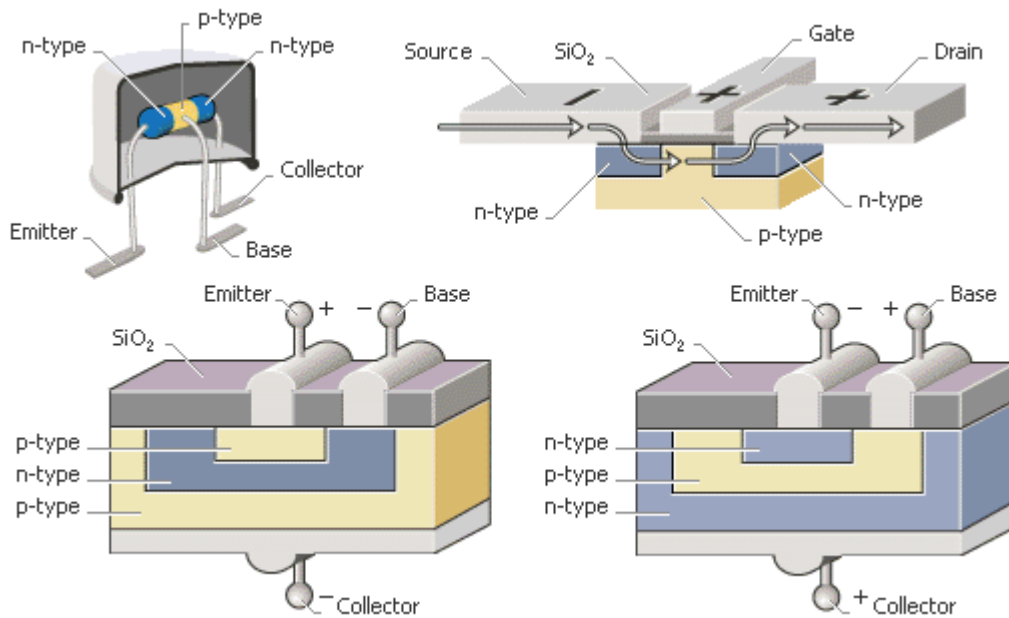
**ثالثا :** بما أن القاعدة تحتوي على عدد قليل من الشوائب إذا عدد الفجوات بها يكون منخفضا وبالتالي يكون عدد الالكترونات التي يملأ هذه الفجوات منخفضا

**رابعا :** تمر معظم الالكترونات من الباعث الى المجمع عبر القاعدة ولا يمر في القاعدة الا عدد قليل من الالكترونات

**خامسا :** بتطبيق قانون كيرشوف على الترانزيستور يكون

شدة تيار الباعث = شدة تيار المجمع + شدة تيار القاعدة

و هذه بعض الصور لنوعي الترانزستور...



الترانزيستور

الترانزيستورات ثنائية القطبية  
كما ذكر سابقا فهناك تصنيف عام لأنواع الترانزيستورات : أحادية القطبية (أونيپولار) و  
ثنائية القطبية (ديپولار) :

(bipolar , unipolar)

وبداية سيعالج النوع الأكثر استعمالا وهو ثنائي القطبية . وهو مكون من ثلاثة طبقات ،  
وثنائي القطبية من جانبه ينقسم أيضا إلى نوعين ( أن بي أن ، وبي أن بي ) :

(NPN , PNP)

وقد تم شرح تصميمة والتفاعلات به في الدرس الثامن في "العناصر النصف موصلة"  
و"الاجتياز إيجابي - سلبي ."

و يصنع في الغالب من مادة السليكون وقليلًا منه يصنع من مادة الجرمانيوم . وله ثلاثة  
وصلات معدنية موصله بطبقاته وتسمى هذه الوصلات :

المجمع (Collector)  
المشع (Emitter)  
القاعدة (Base)

AHMAD AL-HADIDY  
JORDAN –ZARQA  
TEL – 0777409465  
HADIDY\_66@YAHOO.COM